研究成果報告書 科学研究費助成事業

平成 30 年 6 月 6 日現在

機関番号: 12601 研究種目: 若手研究(B) 研究期間: 2015~2017

課題番号: 15K20959

研究課題名(和文)セラミックス粒界における原子結合強度とドーパント添加効果の解明

研究課題名(英文)Investigation of strength and dopant effects at grain boundaries of ceramic materials

研究代表者

栃木 栄太(Tochigi, Eita)

東京大学・大学院工学系研究科(工学部)・助教

研究者番号:50709483

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,100,000円

研究成果の概要(和文): -AI203中の小傾角粒界に種々の元素を添加し、粒界原子構造をTEMにより解析した。粒界には転位が配列しており、添加元素は転位の引張ひずみ領域に選択的に偏析することが明らかとなった。また、偏析分布は元素のイオン価に相関が見られたことから、イオン性結晶における偏析現象は弾性的相互作用に加え電気的相互作用に強く依存することが示唆された。 高精度TEMその場機械試験の実現を目指し、駆動機構を有するMEMSデバイスを設計し性能評価を行った。また、本デバイスに用いる微小試料片の作製方法を検討した。デバイス性能は良好であったが、試料作製方法につ

いてはさらなる改善を要することが明らかとなった。

研究成果の概要(英文): Low-angle grain boundaries of -Al203 with different dopant atoms were investigated by transmission electron microscopy. The grain boundaries were found to consist of a periodic dislocation array. It was revealed that the dopant atoms segregated into the tensile strain region of each dislocation core. In addition, the dopant distributions were related to the valence state of the dopant atoms. Therefore, it was suggested that the dopant segregation behavior in ionic crystals is dependent on not only the elastic interaction but also electrostatic interaction.

To develop a new in-situ TEM mechanical testing system, we designed a MEMS device with an actuator and performed device test in situ. Furthermore, sample preparation methods for experiments using this device were considered. The device performance was up to our expectations. However, it was found that improvements need to be made in the sample preparation.

研究分野: 材料科学

キーワード: 粒界 破壊 セラミックス ドーパント 透過型電子顕微鏡 その場 観察

1.研究開始当初の背景

近年では透過型電子顕微鏡(TEM)をはじめとした原子構造解析技術の進展により、トの原子構造解析技術の進展により、トの原子構造やドーパントの偏析サイをの原子構造となっている。粒界特性をが可視化が可能となっている。粒界特性をが重接が重要に基が重要に基準では、直接観察に基が重要にあたり、その原子構造に関するにあたり、その原子構造に関する力とは言えず、個々の粒界の力を直接評価することが望まれている。とは一般では一個である。とが望まれている。といいにおいて粒界が破壊に対した。とは極めて興味が多くのが現まである。

2.研究の目的

本研究では、結晶粒界の原子構造に対するドーパント添加効果を探求するため、高度に制御された粒界を作製するとともにドーパント添加を行い、その粒界原子構造の直接観察を行う。また、単一粒界の微小領域における破壊現象の直接観察を目指し、高精度TEM その場機械試験法の開発を行う。

3.研究の方法

(1)高精度に方位制御された一組の単結晶を 熱拡散接合することにより単一粒界を有す る双結晶を作製した。この際、単結晶表面に 種々のドーパントをスパッタコーティング することにより、双結晶の作製と同時に粒界 へのドーパント添加を行った。本試料を TEM 観察用薄膜へと加工し、原子分解能を有する 走査型 TEM(STEM)にて粒界原子構造を解析 した。

(2)静電アクチュエーターを搭載した微小電気機械システム(MEMS)を用い、TEM 内その場機械試験法の開発を行った。具体的には、既存の電圧印加 TEM 試料ホルダーへ搭載可能な MEMS デバイスの開発並びに性能評価、TEM 観察用薄膜化法の検討を行った。

(1)α-Al₂O₃ 小傾角粒界におけるドーパントの 偏析構造の直接観察

 α -Al $_2$ O $_3$ において、 $\{11-20\}$ 面を粒界面、<1-100>方向を回転軸とした $\{11-20\}$ /<1-100> 小傾角粒界にはb=1/3<11-20>転位が周期的に配列することが知られている[1]。1/3<11-20> 転位は2 本の部分転位に分解し、それぞれの部分転位コア構造は等価ではなく、上部の部分転位コアは Al 過剰、下部の部分転位コアは O 過剰であることが報告されている[2]。本研究では、これらの部分転位とドーパントとの相互作用を検討した。

図1はNi²⁺(イオン半径:69pm), Er³⁺(89pm), Zr⁴⁺(72pm) を そ れ ぞ れ 添 加 し た {11-20}/<1-100>小傾角粒界中に見られた 1/3<11-20>転位コアの高角度環状暗視野 (HAADF)-STEM 像である。 転位は 2 本の部分 転位に分解しており、それぞれの部分転位コ アは図中矢印で示している箇所に存在して いる。HAADF-STEM 像においては原子番号 の大きい元素ほど明るく結像されるため、図 中の明るいコントラストがドーパントに対 応していると解釈できる。いずれのドーパン トも部分転位コアの下側、つまり引張ひずみ の領域に選択的に偏析していることが分る。 また、HAADF-STEM 像の下に示しているグ ラフは、青、赤それぞれに対応した位置の横 方向の像強度のプロファイルであり、部分転 位コア近傍においてピークが見られること からも転位コアとドーパントが強く相互作 用していることが示唆される。

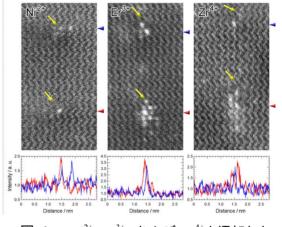


図 1 Ni^{2+} , Er^{3+} , および Zr^{4+} を添加した $\{11-20\}/<1-100>$ 小傾角粒界に形成された 転位構造

まず、バルクのカチオンである Al³+(54pm) と同一のイオン価を有する Er³+のケースに着目すると、上部の部分転位コアよりも下部の部分転位コアに多くの Er³+が偏析していることがわかる。小傾角粒界におけるひずみ場の解析より、下側の部分転位の方がより強い引張ひずみ場を有していることが分った。このことより、Er³+の非対称の偏析分布は弾性的相互作用に因るものであることが示唆される。

4. 研究成果

弾性的相互作用はイオン価に依存しない と考えられるため、いずれのドーパントにお いても下側の部分転位コアにより多く偏析 する傾向にあるはずである。しかしながら、 Ni²⁺のケースにおいては上下の部分転位にほ ぼ均一に偏析している。また、ほぼ同程度の イオン半径をもつ Zr⁴⁺は下側の部分転位に強 く偏析している。これらの偏析分布は弾性的 相互作用のみでは説明することは難しい。こ こで、電気的相互作用を検討する。Ni²⁺はAl³⁺ よりもイオン価が小さいため、Al サイトを置 換した場合、負の正味電荷を持つこととなり、 正の電荷に引き寄せられると考えられる。-方、Zr⁴⁺は逆に負の電荷に引き寄せられると 考えられる。従って、上部の部分転位が正、 下部の部分転位が負の電荷を持つと仮定す れば Ni²⁺および Zr⁴⁺の偏析分布をよく説明で きる。部分転位コア構造の直接観察では、上 部の部分転位コアは Al 過剰、下部の部分転 位コアは〇過剰であった[2]。原子の欠損のな い剛体モデルを仮定する限り、上部の部分転 位は正、下部の部分転位は負の電荷を持つと 考えられ、転位の電荷に関して本実験結果と 同様の結論を与える。

以上より、イオン性結晶におけるドーパントの偏析は弾性的相互作用に加え電気的相互作用に強く依存することが示唆された。また、イオン性結晶において、転位をはじめとするある種の格子欠陥は電荷を有していると考えられる。従って、個々の格子欠陥の電荷状態を解析することはドーパントとの相互作用を検討する上で極めて重要であると考えられる。上記の結果は国際学術誌にて発表された。[雑誌論文-3]

(2) MEMS デバイスによる TEM 内その場 機械試験法の開発

TEM その場観察法は、試料内の微視的組織 変化を直接観察する上で非常に有効な手法 である。TEM その場機械試験においては、イ ンデンテーション試料ホルダーや引張試料 ホルダーが実用化されている。しかし、一般 にこれらのホルダーにおいては傾斜機構が 一軸であり組織観察の自由度が制限される、 また、比較的大きな駆動部を有するため安定 性に限界があるというのが現状である。本研 究ではこれらの問題点を踏まえ、MEMS を用 いた高精度その場機械試験システムの開発 に着手した。図 2 は TEM その場機械試験用 MEMS デバイスの SEM 像である。静電アク チュエーターにより上下に延びる梁は右方 向、左右に延びる梁は上下方向に駆動する。 両梁の交点付近を切断加工し、機械試験用デ バイスとして用いる。本デバイスは2軸傾斜 機構を有する電圧印加 TEM 試料ホルダーに 装着できるよう設計されている。

本デバイスの性能評価試験を行った結果、 二軸傾斜機構、梁の駆動ともに良好に機能することが分かった。デバイスの駆動機構並び に性能評価試験の詳細は国際学術誌にて報 告している[雑誌論文-5]。

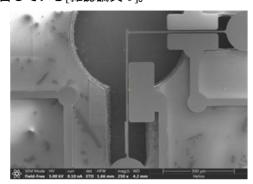


図 2 TEM その場機械試験用 MEMS デバイス

TEM 観察においては試料厚みはナノメー トルオーダーである必要がある。本デバイス の試料保持部は 10um 程度と非常に小さく、 機械研磨やイオン研磨といった通常の試料 作製方法は適用できない。そこで、ナノメー トルオーダーでの微細加工が可能な収束イ オンビーム装置(FIB)を用い、試料作製方法 を検討した。図3はFIBによりTEM観察用 試料を形成した MEMS デバイスの TEM 像 である。テスト試料として Si 製の梁の部分に 直接観察用薄膜を形成している。この像にお いてはコントラストの明暗はおおよそ試料 厚みに対応しており、像中央やや右の明るい 領域が観察位置となる想定である。本試料で は右の梁を上方向に駆動させることで、曲げ 変形試験を行うことを意図している。

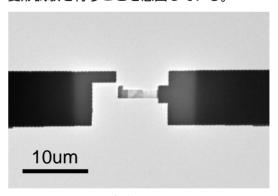


図3 MEMS デバイスの TEM 像。テスト試料として梁の部分に直接観察用薄膜を形成している。

図 4 は薄膜部分の TEM 明視野像である。 試料は変形試験に伴う組織変化を観察である。 を発展まで薄膜化されていることがわかる。 変形試験により変形の開始点を制御するため、薄膜部分には切欠き加工を施している。 像コントラストより切欠き部から下方向の 領域は局所的に薄くなっており、急峻な満になっていると判断できる。このような試料 形状では変形試験時に狭い領域に応力が変形 形状では変形試験時に狭い領域に応力なが 機構となることから、適切な形状ではないと 言える。FIB による加工手順や条件を変更 ることにより、試料厚み方向に均一な形状と なるよう最適化が必要である。

今後は本研究での知見を踏まえ、任意の試料片を MEMS デバイス上に固定、上記のような加工を施し、TEM その場機械試験を実施する。 さらに、 粒界をはじめとする格子欠陥をターゲットとし、 局所領域での変形・破壊現象を探求していく予定である。

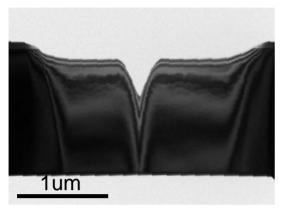


図 4 MEMS デバイスの TEM 明視野像。 テスト試料として梁の部分に直接観察用薄膜を形成している。

<参考文献

- [1] A. Nakamura et al., *Philos. Mag.* **86**, 4657-4666 (2006).
- [2] N. Shibata et al., Science 316, 82-85 (2007).

5 . 主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

[雑誌論文](計 14 件)

- 査読有り [2] E. Tochigi, T. Mizoguchi, E. Okunishi, A. Nakamura, N. Shibata, Y. Ikuhara, "Dissociation reaction of the 1/3<-1101> edge dislocation in α-Al₂O₃", Journal of Materials Science 53, p. 8049-8058 (2018) DOI: 10.1007/s10853-018-2133-7 査読有り [3] E. Tochigi, Y. Kezuka, A. Nakamura, A. Nakamura, N. Shibata, Y. Ikuhara, "Direct Observation of Impurity Segregation at Dislocation Cores in an Ionic Crystal", Nano Letters 17, p. 2908-2912 (2017) DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b00115 査読有り [4] E. Tochigi, S. D. Findray, E. Okunishi, T. Mizoguchi, A. Nakamura, N. Shibata, Y. Ikuhara, " Atomic Structure Characterization of Stacking Faults on the {1-100} plane in α-Alumina by Scanning Transmission Electron

Microscopy", AIP Conference Proceedings 1763, p. 50003 (2016) DOI: 10.1063/1.4961356 査読有り

[5] T. Sato, <u>E. Tochigi</u>, T. Mizoguchi, Y. Ikuhara, H. Fujita, "An experimental system combined with a micromachine and double-tilt TEM holder", *Microelectronic Engineering* **164**, p. 43-47 (2016) DOI:

10.1016/j.mee.2016.06.018 査読有り

[学会発表](計 33 件)

- [1] <u>栃木 栄太</u>, "走査透過型電子顕微鏡法と 理論計算による積層欠陥の解析", 日本金属 学会春期講演大会, 千葉工業大学、千葉県 (2018)
- [2] <u>E. Tochigi</u>, A. Nakamura, N. Shibata, Y. Ikuhara, "Characterization of Dislocation Structures in α -Al₂O₃ by Atomic-resolution STEM", ACTSEA 2017, Kaohsiung, Taiwan, (2017).
- [3] <u>E. Tochigi</u>, A. Nakamura, T. Mizoguchi, N. Shibata, Y. Ikuhara, "Atomic-resolution TEM Characterization of Dislocation Core Structures in Alumina Ceramics", 80th Annual Session of the Indian Ceramic Society, Hyderabad, India, (2016).
- [4] E. Tochigi, A. Nakamura, T. Mizoguchi, N. Shibata, Y. Ikuhara, "TEM study of dislocations and stacking faults in low-angle grain boundaries of alumina", THERMEC2016, Graz, Austria, (2016).
- [5] <u>E. Tochigi</u>, A. Nakamura, T. Mizoguchi, N. Shibata, Y. Ikuhara, "TEM Characterizations of Low-angle Grain Boundaries of α -Al₂O₃", FMS2015, Tokyo, Japan, (2015).

〔その他〕 ホームページ等 http://interface.t.u-tokyo.ac.jp

6. 研究組織

(1)研究代表者

栃木 栄太 (TOCHIGI EITA) 東京大学・大学院工学系研究科・助教 研究者番号:50709483

(2)研究分担者 なし

- (3)連携研究者 なし
- (4)研究協力者 なし